

## 窒化物半導体用新基板 ScAIMgO₄の開発

半導体レーザ,発光ダイオード(LED)お よびトランジスタなどの半導体素子は、基板結 晶上に格子整合条件下で積層された薄膜結晶層 からなっている.この格子整合によって,欠陥 の少ない高品質結晶の成長が実現されている. 半導体素子において,結晶欠陥はしばしば致命 的となる.今年のノーベル物理学賞に輝いた青 色 LED は GaN を主とする窒化物半導体から なっているが,高品質・廉価な GaN 単結晶基 板が存在せず,青色や白色の LED は(0001)面 サファイア基板上に作製されている.この場合, 貫通転位と呼ばれる欠陥が 10<sup>8</sup>/cm<sup>2</sup> 以上含まれ ており,従来からある素子に較べて5桁多い. 窒化物半導体からなる素子特性の改善のために は,結晶品質の改善が急務である.

窒化物半導体の研究が盛んになってきた1980 年代から、東北大学松岡教授(元NTT)をは じめとして、表1に示す種々の基板が検討され てきた、SiCについては、4インチ基板が作製 されている。しかし、成長速度が遅いため、そ の価格は、サファイアに較べて100倍程度高い. また、大型化に関しては、結晶構造に多形が多 いことと、マイクロパイプと呼ばれる結晶欠陥

## 表1 窒化物半導体用基板結晶

基板	ミスマッチ(%)	
	格子定数	熱膨張数
(0001) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.8	- 25.5
$(01\overline{1}0)$ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	-1.9, 2.6	9, 62
(0001)6H-SiC	3.4	25
(101)NdGaO <sub>3</sub>	1.2	20.6
(201)Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10.1	
(111) MgAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	9.5	
(001)LiGaO <sub>2</sub>	+0.2, 2.2	+19.5, 73.5
(001)ScAlMgO <sub>4</sub>	- 1.9	- 37.4, - 10.9
(0001)ZnO	- 1.9	48
(0001)LaBGeO <sub>5</sub>	- 9.7	
ミスフッチ- GaN-基板		
GaN		

が多いことから、サファイア基板が10インチ 成長できているのに対して大型化が困難である. 表1には、各種酸化物結晶を示す.これらの結 晶は、概して、窒化物半導体の薄膜成長に用い る有機金属気相成長(MOVPE)での窒素原料 としてのアンモニアガスや有機金属原料の輸送 に用いる水素ガスなどの還元雰囲気に弱い.こ のような状況の中で、格子不整合の小さい基板 として、ScAIMgO4が開発された.この材料は、 米国のAT&T社のBELL研究所から1995年の Materials Research Society Meeting(米国材 料学会会議, MRS)で発表された.当時は、



図1 ScAIMgO<sub>4</sub>結晶

単結晶もできていなかったが、後に単結晶成長 が実現された.しかしながら、大型化が難し かった.そのため、大型結晶の成長技術の開発 を得意とする福田結晶技術研究所(仙台市,福 田承生社長)に米国から共同研究が持ちかけら れ、大型化の研究が進められた.現在では、図 1に示すように、直径2インチのバルク結晶の 成長に成功している.この結晶の特長である劈 開性を利用して基板を作製できる.そのため、 通常の基板作製には避けて通れない切断や研磨 を必要とせず、基板の作製コストを低減できる. この基板上に、MOVPE 法を用いて GaN 薄膜 が成長されている.還元雰囲気に対する耐性が あることも確認されており、今後、高品質窒化 物半導体成長が期待される.

(東北大学 金属材料研究所 教授 松岡隆志 〒 980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1, E-mail: matsuoka@imr.tohoku.ac.jp) URL: http://www.matsuoka-lab.imr.tohoku. ac.jp/

[2014年11月11日]

## 1 兆分の1 秒以下の世界を 捉える連写カメラ

東京大学の合田圭介教授,佐久間一郎教授, 中川桂一特別研究員,慶應義塾大学の神成文彦 教授らは,Sequentially Timed All-optical Mapping Photography (STAMP)と呼ばれる 新しい超高速度カメラを開発し,1兆分の1秒 を超える撮影速度にて動画を取得することに成 功した.

科学において高速撮影は動的現象を研究する 極めて有用な手法である.しかしながら,既存 の高速度カメラは機械的・電気的動作の限界か ら撮影速度がナノ秒オーダーに制限されており, 将来的にも超高速な動的現象を捉えることが困 難である.一方で,より高速な現象の疑似的動 画を得る手法としてポンプ・プローブ法が用い られるが,この手法は動画をつくるために繰り 返し撮影が必要であり,一度きりしか起こらな い非反復的な現象を捉えられない.

今回開発したのは,光を時間的・空間的に制 御することで動画を撮影するという,既存の高 速度カメラとは異なる動作原理に基づく超高速 撮影システムであり,従来ボトルネックとなっ ていた電気的・機械的な動作を排除することで, サブナノ秒の複雑ダイナミクスを,連続画とし 0 fs 100 μm 190 fs 350 fs 615 fs 885 fs 1130 fs <sup>7π/ン//ルス</sup>

図 擾乱からフォノンパルスが生まれる瞬間
フレーム間隔 229fs (4.37Tfps) にて撮影

てシングルショットで撮影することができる. この原理を実証するため6枚の連続画を取得 するシステムを立ち上げ,65.4Gfpsの撮影速度 にてレーザーアブレーションを,1.23Tfpsおよ び4.37Tfpsの撮影速度にてフォノン・ポラリ トンの超高速ダイナミクスをシングルショット で連続的に取得することに世界で初めて成功し た.

本手法は、巨視的なものから微視的なものま で、従来手法では捉えることができなかった超 高速複雑ダイナミクスを連続画としてシングル ショットで可視化することができる、今後、破 壊現象,化学反応,プラズマ現象,物質中の電 子や熱の移動,スピン波や光の伝播などさまざ まな超高速現象を観察できる可能性を持ち,研 究開発において多くの未知の現象の発見や解明 に貢献することが期待される.

(東京大学大学院理学系研究科 中川桂一・合田 圭介 連絡先:〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1, E-mail:knakagawa@chem.s.u-tokyo. acjp, goda@chem.s.u-tokyo.acjp)

URL:http://www.goda.chem.s.u-tokyo.ac.jp [2014 年 11 月 13 日]